

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 4 区分

【発行日】平成 18 年 10 月 19 日 (2006.10.19)

【公開番号】特開 2005-285197 (P2005-285197A)

【公開日】平成 17 年 10 月 13 日 (2005.10.13)

【年通号数】公開・登録公報 2005-040

【出願番号】特願 2004-95876 (P2004-95876)

【国際特許分類】

G 1 1 C 16/06 (2006.01)

G 1 1 C 16/02 (2006.01)

【F I】

G 1 1 C 17/00 6 3 4 C

G 1 1 C 17/00 6 3 4 B

G 1 1 C 17/00 6 3 2 A

G 1 1 C 17/00 6 4 1

G 1 1 C 17/00 6 1 1 A

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 8 月 31 日 (2006.8.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 4】

前記半導体記憶装置は、前記選択メモリセルのデータ読出基準の参照電流を生成する参照セルをさらに備え、

前記センス増幅回路は、

前記読出部として作用するカレントミラー段と、

基準バイアス電圧により伝達電圧レベルが制限され、前記プリチャージ段からの電流を前記選択メモリセルおよび前記参照セルに供給する電圧供給段と、

前記選択メモリセルおよび前記参照セルがそれぞれ結合されるデータ線を所定電位に初期設定する初期段と、

前記カレントミラー段の出力ノードをイコライズするイコライズ段とを備える、請求項 1 記載の半導体記憶装置。